

NdGaO₃(ネオジムガレート)基板

直方晶の結晶構造をとりますが、(110)面や(001)面の場合、Ga-Ga 間距離がおよそ0.386nm となりSrTiO₃基板とLaAlO₃基板の中間の格子定数を持つ基板として広く用いられています。化学量論融液からCZ法で育成しているため高品質な結晶を安定して得ることができます。

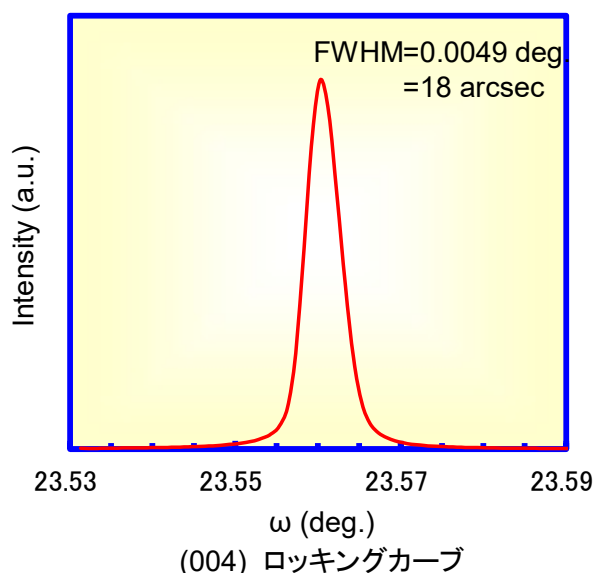
【特長】

- ・SrTiO₃基板とLaAlO₃基板の間の格子定数
- ・高品質な結晶を安定的に得られる
- ・社内製結晶のためQCDに優れた基板を提供



【諸性質】

結晶系	直方晶(斜方晶)
結晶構造	ペロブスカイト型構造
格子定数	a = 0.5431 nm b = 0.5499 nm c = 0.7710 nm
融点	1650 °C
密度	7.56 g/cm ³
誘電率	20~25 (27°C, 1MHz)
熱膨張係数	10 × 10 ⁻⁶ /°C



【標準仕様】

面方位	(100), (001), (110), (011) 公差: ±0.5°
サイズ	10 × 10 × 0.5mm 15 × 15 × 0.5mm 外形公差: ±0.1mm, 厚み公差: ±0.05mm
研磨	片面 / 両面
表面粗さ	Ra ≤ 1.0nm, Rmax ≤ 5.0nm
平坦度	10 × 10 × 0.5mm: ≤ λ 15 × 15 × 0.5mm: ≤ 1.5λ (λ = 632.8nm)



詳しく知りたい方はこちら

※お客様のご要望により特殊仕様も承ります。

グラフや表の値は代表値であり、保証値ではありません。

仕様

サイズ	研磨	面方位			
		(100)	(001)	(110)	(011)
10x10x0.5mm	片面	○	○	★	△
〃	両面	△	△	△	△
15x15x0.5mm	片面	△	△	△	△
〃	両面	△	△	△	△

★:計画在庫品

○:標準品

△:受注生産品

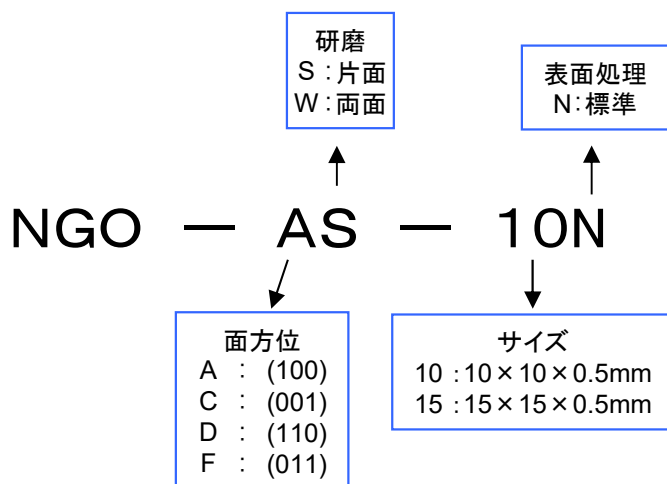
☆計画在庫品:即納できるよう定期的に生産を管理しております。

(予告なく変更することがあります。予めご了承ください。)

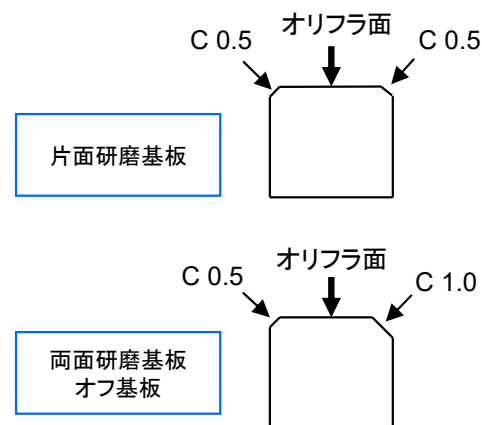
サイズ違い、オフ基板についても承ります。お問い合わせ下さい。

※受注生産品および特殊仕様品は、5枚から承ります。

型番



オリフラ



基板面方位	オリフラ
(100)	(001)
(001)	(100)
(110)	(001)
(011)	(100)

<外観検査基準について>

・外周から0.2mm以下、厚みの1/2以下のカケは不問とさせていただきます。

・片面研磨品の裏面キズ、シミは不問とさせていただきます。

お問い合わせは

SHINKOSHA Co., Ltd.

株式会社 信光社 営業部

〒247-0007神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷2-4-1

TEL: 045-892-4393, FAX: 045-892-2986

E-mail: sales@shinkosha.com

URL: http://www.shinkosha.com/